

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Туранова Сергея Борисовича «Энергоэффективная адаптивная оптико-электронная система облучения» по специальности 05.11.07 - Оптические и оптико-электронные приборы на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Шамирзаев Тимур Сезгирович
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук, 01.04.10 - «Физика полупроводников»
Ученое звание (по кафедре, специальности)	Старший научный сотрудник
Основное место работы	
Должность	Ведущий научный сотрудник
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	Лаборатория молекулярно-лучевой эпитаксии соединений АЗВ5
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	630090 Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева 13 http://www.isp.nsc.ru +7(383)330-90-55 ifp@isp.nsc.ru
Публикации по специальности 05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы»» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
1. L. V. Kotova, A. V. Platonov, V. N. Kats, T. S. Shamirzaev, R. AndréV., P. Kochereshko Nonreciprocal Optical and Magneto-optical Effects in Semiconductor Quantum Wells // Physics of the Solid State, November 2018, Volume 60, Issue 11, pp 2269–2275	
2. D. S. Abramkin, M. O. Petrushkov, M. A. Putyato, B. R. Semyagin, T. S. Shamirzaev Heterostructures with InAs/AlAs Quantum Wells and Quantum Dots Grown on GaAs/Si Hybrid Substrates // Semiconductors, November 2018, Volume 52, Issue 11, pp 1484–1490	
3. Shamirzaev V.T., Gaisler V.A., Shamirzaev T.S. Negative differential resistance in high-power InGaN/GaN laser diode // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing, Volume 52, Issue 5, 1 September 2016, Pages 442-446	
4. Шамирзаев В.Т., Гайслер В. А., Шамирзаев Т.С. Краевая и дефектная люминесценция мощных InGaN/GaN ультрафиолетовых светоизлучающих диодов // Физика и техника полупроводников. 2016. Т. 50. № 11. С. 1513-1518	

5. A. V. Shevlyagin, D. L. Goroshko, E. A. Chusovitin, S. A. Balagan, S. A. Dotcenko, K. N. Galkin, N. G. Galkin, T. S. Shamirzaev, A. K. Gutakovskii, A. V. Latyshev, M. Iinuma, and Y. Terai A room-temperature-operated Si LED with β -FeSi₂ nanocrystals in the active layer: μ W emission power at 1.5 μ m // Journal of Applied Physics 2017, Volume 121, Pages 113101-9

Официальный оппонент

Т.С. Шамирзаев

Верно

Ученый секретарь ИФП СО РАН



С.А. Аржанникова